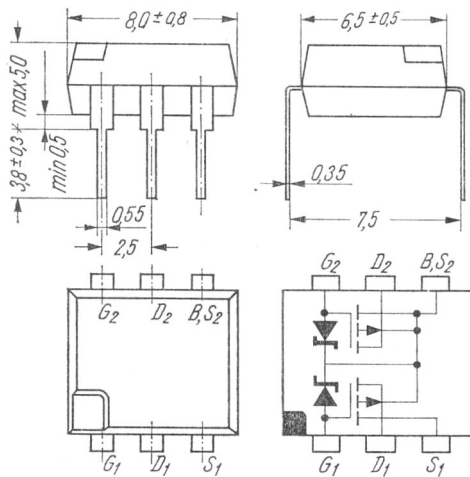


SMY51



Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: RFT

Wykonanie: podwójny tranzystor polowy MOS (kanał typu *P* normalnie wyłączony) w obudowie plastikowej z zabezpieczającymi diodami scalonymi. Źródło tranzystora 2 jest połączone z podłożem wewnątrz obudowy, ciężar około 0,4 G

Zastosowanie: układy cyfrowe, element unipolarnej serii układów scalonych

Typy podobne: MEM550 (GI)

Rys. 1-1059. SMY51

Wartości charakterystyczne¹⁾

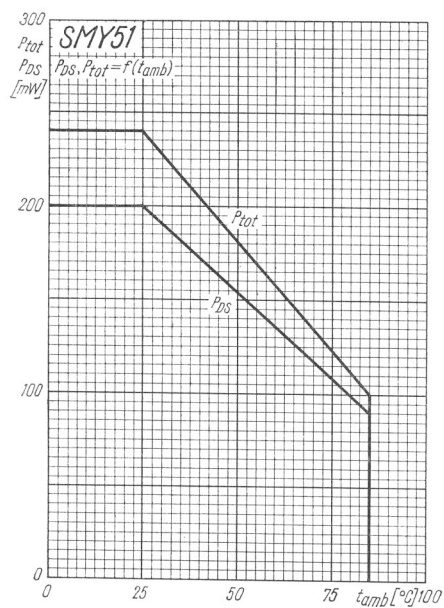
	min	typ	max		
$-I_D$	3			mA	przy $-U_{DS} = 2$ V, $-U_{GS} = 10$ V, $-U_{SB} = 0$
$-U_T$	3			V	przy $U_{DS} = U_{GS}$, $-U_{SB} = 0$, $-I_D = 10$ μ A
$-I_{GSS}$			10	μ A	przy $-U_{DS} = 0$, $-U_{GS} = 31$ V, $-U_{SB} = 0$
$-I_{DSS}$			0,1	μ A	przy $-U_{DS} = 0$, $-U_{GS} = 20$ V, $-U_{SB} = 0$
$-I_{DSS}$			10	μ A	przy $-U_{DS} = 31$ V, $-U_{GS} = 0$, $-U_{SB} = 0$
$-I_{DSS}$			0,1	μ A	przy $-U_{DS} = 20$ V, $-U_{GS} = 0$, $-U_{SB} = 0$
$-C_{gss}$			12	pF	przy $-U_{DS} = 0$, $-U_{GS} = 0$, $-U_{DB} = 0$
$-I_D$		10		mA	przy $-U_{DS} = 10$ V, $-U_{GS} = 10$ V
y_{21}		3,6		mS	przy $-U_{DS} = 10$ V, $-U_{GS} = 0$, $f = 1$ kHz
R_{DS}		150		Ω	przy $-I_D = 100$ μ A, $-U_{GS} = 20$ V

Wartości graniczne

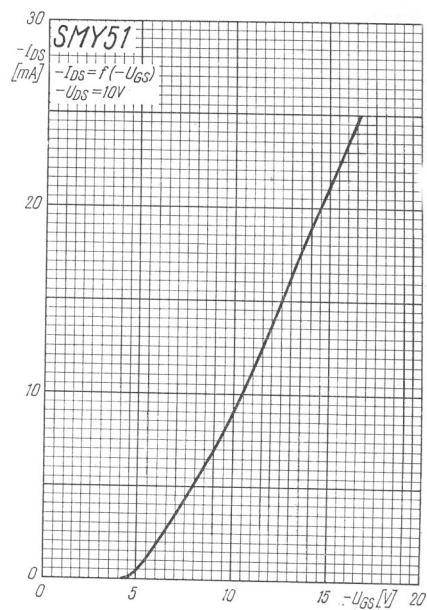
$-U_{DS \text{ max}}$	$31 \div -0,3$	V	$I_{GSM \text{ max}}$	2	mA
$-U_{GS \text{ max}}$	$31 \div -0,3$	V	$P_{DS \text{ max}}$	200	mW
$-U_{DG \text{ max}}$	$31 \div -31$	V	$P_{tot \text{ max}}$	240 ²⁾	mW
$-U_{SB \text{ max}}$	0	V	t_{stg}	$-40 \div +125$	$^{\circ}\text{C}$
$-I_D \text{ max}$	20	mA	t_{amb}	$-25 \div +85$	$^{\circ}\text{C}$
$-I_G \text{ max}$	0,1	mA			

¹⁾ $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

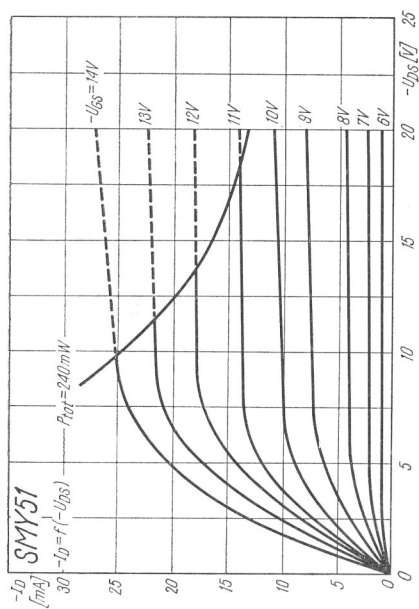
²⁾ dwa tranzystory, $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$



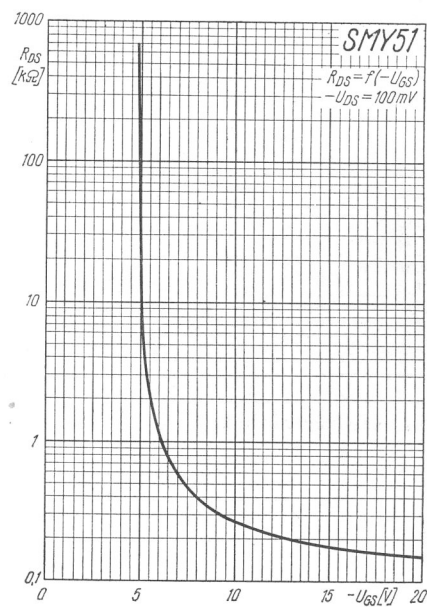
Rys. 1-1060. Zależność dopuszczalnej mocy strat od temperatury otoczenia



Rys. 1-1061. Charakterystyka wejściowa



Rys. 1-1062. Charakterystyki wyjściowe



Rys. 1-1063. Zależność rezystancji R_{DS} od napięcia bramki